

關於碳化硅外延層厚度確定的數學建模與算法分析報告

2025 年 9 月 6 日

摘要

本報告針對紅外干涉法測量碳化硅 (SiC) 外延層厚度的問題，建立了一套從理論建模到數據處理的完整分析流程。首先，基於薄膜干涉原理，我們推導了描述光程差 (OPD) 與外延層厚度 d 、折射率 n_1 及入射角 θ 之間關係的二光束干涉模型。其次，針對模型中 n_1 未知且存在色散的問題，我們設計了一種基於快速傅立葉變換 (FFT) 的穩健算法，該算法能直接從光譜數據中提取 OPD。在處理 SiC 樣品數據 (附件 1、2) 時，我們識別並排除了材料本徵吸收帶 (Reststrahlen band) 的干擾，通過對比雙角度測量結果，論證了在高折射率材料中應用引入先驗知識的策略。最終確定 SiC 外延層厚度 $d = 7.73 \pm 0.01 \mu\text{m}$ 。最後，通過分析硅樣品 (附件 3、4) 的 OPD 譜譜波成分，我們確證了多光束干涉的存在性，闡述了其對測量精度的影響及相應的建模策略 (Airy 模型)。本報告所提方法具有高精度和魯棒性，對半導體薄膜的無損檢測提供了可靠的解決方案。

1 二光束干涉模型的建立

1.1 物理情景分析

紅外光入射到外延層表面時，發生反射和折射。如圖 1 所示，‘反射光 1’由空氣-外延層界面直接反射形成；‘反射光 2’由入射光折射進入外延層，經外延層-襯底界面反射後，再次折射回空氣中形成。這兩束光因傳播路徑不同而產生光程差，從而發生干涉。

1.2 數學推導

1. 基本參數定義：

- d : 外延層厚度。
- θ_i : 空氣中的入射角。
- θ_r : 外延層中的折射角。
- n_0 : 空氣折射率，設 $n_0 = 1$ 。
- n_1 : 外延層折射率。
- λ : 真空中的波長； $\tilde{\nu} = 1/\lambda$: 波數。

2. 斯涅爾定律 (Snell's Law): 光在空氣-外延層界面的折射遵循斯涅爾定律：

$$n_0 \sin \theta_i = n_1 \sin \theta_r \implies \sin \theta_r = \frac{\sin \theta_i}{n_1}$$

3. 光程差 (Optical Path Difference, OPD) 計算： ‘反射光 2’相較於 ‘反射光 1’增加的光程主要發生在外延層 E 部。其幾何光程差 OPD_{geom} E ：

$$\text{OPD}_{\text{geom}} = 2n_1 d \cos \theta_r$$

利用 $\cos \theta_r = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_r} = \sqrt{1 - (\sin \theta_i / n_1)^2}$ ，可得：

$$\text{OPD}_{\text{geom}} = 2d\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_i}$$

4. 相位突變分析： 光的反射可能伴隨相位突變。當光從光疏介質射向光密介質時，反射光有 π 相位突變（相當於 $\lambda/2$ 光程）。

- **界面 1 (空氣-外延層)：** $n_1 > n_0$ (SiC 折射率約 2.6 > 空氣 1)，發生 π 相位突變。
- **界面 2 (外延層-襯底)：** 襯底通常 E 重摻雜 SiC，其載流子效應會使其在紅外波段的折射率 n_2 低於輕摻雜的外延層 n_1 。因此假設 $n_1 > n_2$ ，反射時~~無~~相位突變。

兩束光之間存在一次 E 的 π 相位突變。值得注意的是，即使 $n_1 \leq n_2$ 的假設成立（即界面 2 也發生 π 相位突變），總的 E 相位差將變 E 0 或 2π 。這僅會將相長與相消干涉的條件互 E 。然而，由於我們後續 E 用的傅立葉變 E 算法是對信號的振 E 頻率進行分析，而非依賴於極值的 E 對位置，因此該算法的結果對於相位突變的假設是穩健的。

5. 干涉條件方程：

- **相消干涉 (反射率極小值)：** 總光程差 E 波長的整數倍 $m\lambda$ 。

$$\text{OPD}_{\text{geom}} + \frac{\lambda}{2} = m\lambda \implies \text{OPD}_{\text{geom}} = \left(m - \frac{1}{2}\right) \lambda$$

- **相長干涉 (反射率極大值)：** 總光程差 E 半波長的奇數倍 $(m + 1/2)\lambda$ 。

$$\text{OPD}_{\text{geom}} + \frac{\lambda}{2} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \implies \text{OPD}_{\text{geom}} = m\lambda$$

1.3 最終模型

將 OPD_{geom} 代入相長干涉條件（對應反射光譜的峰值），得到用於厚度計算的基本模型：

$$2d\sqrt{n_1(\tilde{\nu})^2 - \sin^2 \theta_i} = \frac{m}{\tilde{\nu}_{\text{max}}}$$

其中 m E 干涉級數（正整數）， $n_1(\tilde{\nu})$ 表示折射率隨波數變化的色散關 E 。此模型構成了後續算法設計的基礎。

2 SiC 外延層厚度算法設計、計算與可靠性分析

2.1 算法設計：傅立葉變 E 法

直接求解模型 (1.3) 面臨兩大挑戰：(1) 干涉級數 m 未知；(2) 折射率 $n_1(\tilde{\nu})$ 是未知的 E 雜函數。我們 E 用傅立葉變 E 法規避這些問題。干涉信號 $R(\tilde{\nu})$ 在波數域的振 E 可以視 E 一個調頻信號，其「瞬時頻率」與 OPD 相關。對 $R(\tilde{\nu})$ 進行傅立葉變 E ，可以將其變 E 到共 E 域——光程差域。在 OPD 譜上，干涉信號將在 $\tilde{\nu}_{\text{center}}$ 對應的平均光程差 OPD_{avg} 處形成一個清晰的峰值。

算法步驟：

1. **數據加載與預處理：**讀取光譜數據 $(\tilde{\nu}, R(\tilde{\nu}))$ 。
2. **數據篩選：**識別並排除物理模型不適用的區域（如材料本徵吸收帶）。
3. **插值：**將非均勻樣的波數數據通過線性插值轉為均勻網格，以滿足 FFT 算法要求。
4. **基線校正：**用 Savitzky-Golay 濾波器擬合光譜的低頻背景趨勢。該背景主要由儀器響應函數和材料的宏觀光學特性貢獻，其移除是為了分離出高頻的干涉信息。
5. **加窗與 FFT：**對提取出的干涉信號應用 Hanning 窗函數，以抑制因數據截斷而產生的頻譜漏 (spectral leakage)，確保 OPD 譜峰的準確性和信噪比。隨後執行 FFT 計算功率譜。
6. **峰值提取：**在 OPD 功率譜上定位最峰值的位置，即平均光程差 OPD_{avg} 。

2.2 數據分析與結果

1. SiC 樣品（附件 1、2）初步分析與模型精煉：

- **現象識別：**SiC 光譜在 $750\text{-}1000\text{ cm}^{-1}$ 範圍內存在強烈的 Reststrahlen 吸收帶。此區域的光學響應由晶格振動主導，不符合透明薄膜干涉模型。
- **策略調整：**保證模型有效性，我們將分析範圍限制在 1200 cm^{-1} 至 4000 cm^{-1} 的透明區。

2. 雙角度測量分析：

- **數據獲取：**對附件 1 ($\theta_i = 10^\circ$) 和附件 2 ($\theta_i = 15^\circ$) 的篩選後數據執行 FFT 算法，得到光程差：

$$- OPD_{10^\circ} = 39.7371\text{ }\mu\text{m}$$

$$- OPD_{15^\circ} = 39.7371\text{ }\mu\text{m}$$

- **方法局限性論證：**兩個角度下的 OPD 值在數值精度上完全相同。這是因為 SiC 的折射率 $n_1 \approx 2.6$ 遠大於 $\sin(15^\circ) \approx 0.26$ ，導致 $\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_i}$ 項對 θ_i 的變化極不敏感。因此，試圖聯立求解 d 和 n_1 的方法在此失效。

3. 引入先驗知識求解：

- **求解上述問題，我們引入物理先驗知識。**根據學術文獻（例如，S. Adachi, "Optical Constants of Crystalline and Amorphous Semiconductors"），4H-SiC 晶體在該紅外波段的折射率 n_1 約為 2.58。我們以此作為計算中的有效折射率。

- **厚度計算：**

$$d = \frac{OPD}{2\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_i}}$$

$$- \text{使用 } \theta_i = 10^\circ \text{ 數據: } d = 39.7371 / (2\sqrt{2.58^2 - \sin^2(10^\circ)}) = 7.719\text{ }\mu\text{m}.$$

$$- \text{使用 } \theta_i = 15^\circ \text{ 數據: } d = 39.7371 / (2\sqrt{2.58^2 - \sin^2(15^\circ)}) = 7.740\text{ }\mu\text{m}.$$

2.3 可靠性分析與結論

兩個角度的計算結果高度一致（相對偏差僅 0.27%），證明了我們的模型、算法和引入的先驗知識是自洽且可靠的。

最終結論： 碳化硅外延層的厚度 $d = 7.73 \pm 0.01 \mu\text{m}$ 。此處的不確定度 $\pm 0.01 \mu\text{m}$ 是基於兩個不同入射角計算結果（ $7.719 \mu\text{m}$ 和 $7.740 \mu\text{m}$ ）之間半差的保守估計，它反映了測量數據和所用折射率常數的綜合影響。

3 多光束干涉分析

3.1 理論推導：干涉條件與精度影響

1. **干涉條件：** 當光在外延層發生多次反射時（如圖 2 所示），多束反射光相加形成多光束干涉。其顯著發生的必要條件是：

- **高反射率：** 界面反射係數 r_{01}, r_{12} 較大，使得多次反射後的光不可忽略。
- **低吸收損耗：** 薄膜介質的吸收係數 k 很小，光能在層內傳播損耗低。

2. **精度影響：** 多光束干涉導致干涉條紋的形狀從二光束干涉的余弦形變為更尖銳的艾里函數 (Airy function) 形狀。在頻譜上表現除了基頻峰外，還會出現高次諧波峰（位於基頻峰的 2 倍、3 倍... 處）。若仍用二光束模型分析，高次諧波的存在會干擾基頻峰的精確定位，從而降低厚度計算的精度。

3.2 數據分析：硅樣品（附件 3、4）

1. **實驗證據：** 對附件 3（硅樣品）的光譜數據執行 FFT 分析，得到其 OPD 譜。在 OPD 譜上觀測到兩個顯著峰值：

- **基頻峰：** $\text{OPD}_1 = 24.65 \mu\text{m}$
- **二次諧波峰：** $\text{OPD}_2 = 51.38 \mu\text{m}$

諧波峰的位置與基頻峰的比值 $\text{OPD}_2/\text{OPD}_1 \approx 2.08$ ，這非常接近理論值 2。

2. **結論：** 硅樣品 OPD 譜中清晰的二次諧波峰是多光束干涉存在的確鑿證據。這與硅材料的高折射率（約 3.4）導致的高界面反射率相符。

3.3 SiC 樣品的多光束干涉評估與消除

- **評估：** 對 SiC 樣品（附件 1、2）精煉後的 OPD 譜進行分析，未發現任何顯著高於噪聲水平的諧波峰。
- **結論：** SiC 樣品的多光束干涉效應非常微弱，可以忽略不計。
- **影響消除：** FFT 算法本身具有濾波特性的。通過提取基頻峰位置來計算厚度，已經天然地濾除了高次諧波的影響。因此，問題二中的計算結果 $d = 7.73 \mu\text{m}$ 已是消除多光束干涉影響後的精確值。

總結

本報告通過建立嚴謹的物理模型，設計並實施了穩健的數據分析算法，成功解決了 SiC 外延層厚度的確定問題。通過對真實數據的深入分析，我們不僅精確計算了目標參數，還探討了模型的適用邊界和局限性，展示了在複雜情況下結合先驗知識解決實際問題的科學方法。